

2SB1076M 2SB1239

エピタキシャルプレーナ形 PNP シリコンダーリントントランジスタ
低周波電力増幅用/Low Freq. Power Amp.
Epitaxial Planar PNP Silicon Darlington Transistors

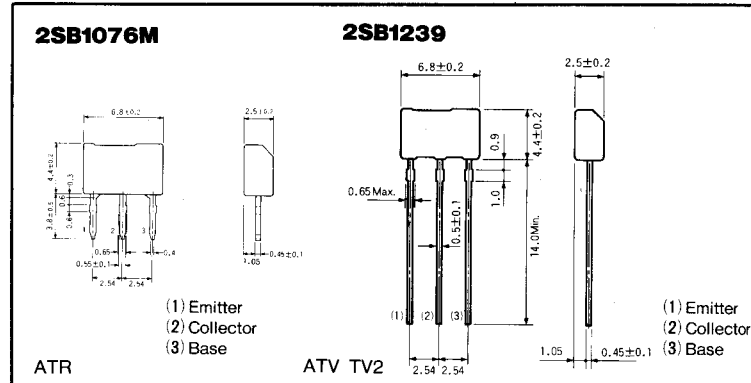
● 特長

- 1) ダーリントン接続で高 h_{FE} である。
- 2) BE間に約 $4k\Omega$ の抵抗を内蔵。温度安定性が良い。

● Features

- 1) Darlington connection provides high DC current gain (h_{FE}).
- 2) Built-in resistance of approx. $4k\Omega$ across base and emitter. Excellent temperature stability.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



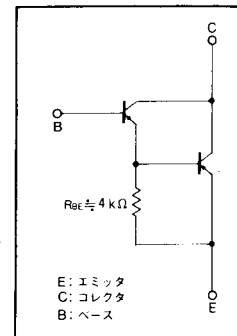
注：ATVの外形仕様については、TV3/4/6タイプも用意しています（p.38参照）。

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-40	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CER}	-40	V ($R_{BE}=10k\Omega$)
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-2	A
コレクタ損失	P_C	1	W*
接合部温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度範囲	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$

* プリント基板：
コレクタ部分の
銅箔面積 $1cm^2$
以上、厚み1.7
mm

● 内部等価回路図



● 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CER}	-40	-	-	V	$I_C=-1mA, R_{BE}=10k\Omega$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	-40	-	-	V	$I_C=50\mu A$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	-5	-	-	V	$I_E=-50\mu A$
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	-	-	-1	μA	$V_{CB}=-24V$
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	-	-	-1	μA	$V_{EB}=-4V$
エレクト・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	-	-0.80	-1.5	V	$I_C/I_B=-0.6A/-1.2mA$
直流電流増幅率	h_{FE}	1 000	-	-	-	$V_{CE}/I_C=-3V/-0.5A$
利得帯域幅積	f_T	-	150	-	MHz	$V_{CE}=-6V, I_E=0.1A$
出力容量	C_{ob}	-	11	-	pF	$V_{CB}=-10V, I_E=0A, f=1MHz$

● 標準品・準標準品一覧表

(◎:標準品 ○:準標準品)

Type	h_{FE}	包装名 記号 基本発注単位(個)	バルク		コンテナ		テーピング	
			1 000	4 000	C2	TV2	TV3	TV3
2SB1076M	A (1 000以上)	◎	○	-	-	-	-	-
2SB1239	A (1 000以上)	-	-	◎	○	-	-	-